

Семеро политехников удостоены грантов Президента РФ

В День города, 27 мая, в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) состоялась торжественная церемония по присуждению грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых. В число 52 грантополучателей – представителей вузов Санкт-Петербурга и учреждений Российской академии наук – вошли семь молодых ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.



Свидетельства на право получения гранта Президента РФ молодым ученым вручал полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И. БУЛАВИН.

В приветственном слове Владимир Иванович отметил, что общественное и государственное признание важно в любом деле, в любой профессии. «Благодаря вам преумножается уникальный научный потенциал нашей страны, рождаются прорывные идеи, создаются современные технологии и наукоемкие производства», – обратился к победителям полпред Президента.



«Сегодня перед Россией стоят масштабные задачи, – продолжает В.И. БУЛАВИН. – Нам необходимо двигаться вперед во всех областях: укреплять экономику, обороноспособность страны, развивать социальную сферу. И, конечно, для этого нужны и эффективная система образования, и сильная наука, и собственные передовые технологии».

К победителям конкурса и руководителям высших учебных заведений, которые также присутствовали на торжественном мероприятии, обратился и председатель Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого А.И. РУДСКОЙ. Андрей Иванович привел статистические данные, отметив, что в этом году конкурс на получение грантов Президента РФ был необычайно высок – 1 к 10. «Великая заслуга нашего государства в том, что оно поддерживает научные изыскания российских молодых ученых, – отметил А.И. РУДСКОЙ. – И мы будем эту практику расширять: на последнем заседании Совета по грантам Президента нами было принято решение выступить с инициативой на предмет увеличения суммы грантовой поддержки».



По числу студентов, обучающихся в вузах, Санкт-Петербург занимает второе место среди субъектов Российской Федерации. Основной кадровый потенциал образовательных и научных учреждений сосредоточен именно в нашем городе, отсюда и столь высокие результаты по присуждению грантов Президента РФ по Санкт-Петербургу. «Вы еще раз доказали всей России, что Северо-Запад и Санкт-Петербург являются сосредоточением ведения самых передовых научных изысканий, – обратился к победителям А.И. РУДСКОЙ. – Наш регион обеспечивает Россию высокоинтеллектуальными кадрами, которые будут ковать великую науку, великую промышленность и великую безопасность нашего государства».

Молодые ученые успешно проявляют себя в технических и инженерных сферах, медицине, физике, химии, биологии – в тех областях, которые определяют технологический прогресс, позицию страны в глобальной конкуренции, в отраслях экономики будущего, в обеспечении высоких стандартов и качества жизни наших граждан.



Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И. БУЛАВИН выразил уверенность, что высокая заслуженная награда станет для молодых ученых стимулом к продолжению смелого научного поиска и развитию таланта на благо России.

В экспресс-интервью корреспонденту Медиа-центра политехники, удостоенные гранта Президента РФ, рассказали о своих проектах и поделились впечатлениями от столь значимого в их жизни события.

Н.В. АНДРЕЕВА, доцент кафедры «Физическая электроника» ИФНиТ



Тема проекта: «Исследование полярных нанодоменов в массивных и тонкопленочных смешанных сегнетоэлектриках со структурой перовскита»

«Моя работа посвящена исследованию перспективных функциональных материалов, которые, как считается, дадут толчок развития новому типу электронных устройств. Именно эта работа посвящена конкретному типу материалов – это тонкие пленки и массивные материалы, в которых происходят очень интересные процессы. Их можно использовать для конструктивных элементов электроники. Ряд направлений деятельности моей научной группы посвящены исследованию функциональных материалов для биомедицины и современных энергосберегающих технологий.

Грант Президента я получаю впервые, это приятное событие в моей жизни, которое послужит стимулом к увеличению работоспособности по моему профилю».

А.А. НАУМОВ, доцент кафедры «Технология и исследования материалов» ИММиТ



Тема проекта: «Формирование структуры высокопрочных алюминиевых сплавов при сварке трением с перемешиванием»

«Целью моего проекта является изучение особенностей структурообразования в алюминиевых сплавах при сварке трением с перемешиванием, определение, каким образом параметры процесса сварки сказываются на свойствах шва. Для этого была проведена экспериментальная работа на новой уникальной установке для сварки трением с перемешиванием, которая находится в нашем университете.

Я уже в третий раз выигрываю грант Президента, очень надеялся его получить вновь, поскольку финансовая поддержка является одним из основных факторов успешной научной деятельности».

А.Н. СОФРОНОВ, доцент кафедры «Физика полупроводников и наноэлектроники» ИФНиТ



Тема проекта: «Внутризонные оптические явления в наноструктурах с квантовыми ямами и квантовыми точками»

«Общей идеей проекта является экспериментальное изучение процессов взаимодействия света с дискретными состояниями носителей заряда в полупроводниковых структурах с квантовым пространственным ограничением. Эти исследования, являющиеся скорее фундаментальными по своей сути, интересны и с практической точки зрения. Так, в перспективе они могут стать физической основой для разработки новых или усовершенствования существующих приборов оптоэлектроники на средний и дальний инфракрасный диапазон».

**Р.Г. БУРКОВСКИЙ, старший научный сотрудник, доцент кафедры
«Физическая электроника» ИФНиТ**



Тема проекта: «Структурные превращения в функциональных материалах на основе антисегнетоэлектриков и их твердых растворов»

«Мы исследуем микроскопические механизмы, влияющие на поведение антисегнетоэлектрических материалов. Они широко применяются в электронике, медицине, автопромышленности. Мы изучаем возможности по целенаправленному изменению практически значимых свойств материала за счет сравнительно малых внешних воздействий, таких как контролируемые механические микронапряжения, электрические поля, химическая модификация кристаллов.

Я очень рад, что наша страна находит способы помочь наиболее способным людям крепко встать на ноги в той области, где они могут быть наиболее для нее полезны».

**А.Н. ЛИТВИНОВ, доцент кафедры «Теоретическая физика» ИФНиТ,
старший научный сотрудник кафедры «Квантовая электроника»
ИФНиТ**



Тема проекта: «Управление оптическими свойствами атомных систем в условиях замкнутого контура возбуждения»

«Суть моего проекта заключается в исследовании взаимодействия многочастотного лазерного излучения с атомными средами и исследовании новых оптических эффектов, которые возникают в таких средах. Изучение этих проблем важно при разработке атомных часов нового поколения, которые составляют основу для систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. Разработка более точных атомных часов компактных размеров позволит повысить точность позиционирования систем спутниковой навигации. Другой ветвью применимости результатов проекта является поиск новых способов управления показателем преломления среды, что в перспективе может позволить создать фотонный квазикристалл с перестраиваемой фотонной зоной путём изменения характеристик лазерных полей».

М.Я. ВИННИЧЕНКО, старший научный сотрудник, старший преподаватель кафедры «Физика полупроводников и наноэлектроники» ИФНиТ



Тема проекта: «Исследование оптических явлений в узкозонных полупроводниковых структурах для оптоэлектронных приборов среднего инфракрасного диапазона»

«В области длин волн 2..4 мкм лежат спектры поглощения различных газов и вредных веществ, однако, на настоящий момент отсутствуют эффективные источники и приемники этого излучения. Лазеры и детекторы на этот диапазон могут использоваться для спектроскопии и экологического мониторинга, беспроводной связи, диагностики и лечения заболеваний. Уже созданы полупроводниковые лазеры на базе Sb-содержащих соединений, работающие в вышеуказанном диапазоне длин волн, но для расширения областей их применения необходимо улучшение их характеристик.

Исследования, проводимые в нашей лаборатории под руководством моих наставников, профессоров Дмитрия Анатольевича Фирсова и Леонида Евгеньевича Воробьева, направлены на выработку рекомендаций по выбору параметров структур для улучшения приборных характеристик полупроводниковых лазеров на базе Sb-содержащих соединений».

И.В. СИДОРЧУК, доцент кафедры «История» ГИ



Тема проекта: «Институционализация новых научных учреждений в 1920-х годах: проблемы и решения (на примере Петрограда-Ленинграда)»

«Мое исследование посвящено истории институционализации новых научных учреждений в Петрограде-Ленинграде 1920-х годов. Это было время смелых, подчас утопичных и действительно революционных проектов, многие из которых оказали влияние на развитие не только отечественной, но и мировой науки. В рамках исследования я планирую выявить причины и практики реализации научных проектов, наиболее характерные для рассматриваемого периода, показать механизмы их распространения, а также особенности восприятия ученым сообществом и властью. Это позволит существенно дополнить картину научной повседневности эпохи нэпа.

На президентский грант я подавал заявку три раза, и, наконец, выиграл, чему очень рад. Советую всем политехникам, как преподавателям, так и студентам, активно участвовать в научных конкурсах. Поверьте, если ваше исследование интересно и актуально, рано или поздно вы будете вознаграждены. И пусть неудачи вас не расстраивают, ведь “кто хочет – тот добьется”. Хочу поблагодарить за помощь в подготовке заявки Отдел развития научной деятельности студентов и молодых ученых, а также выразить слова признательности профессору моей кафедры Светлане Борисовне Ульяновой за ценные консультации».

Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ

Дата публикации: 2016.05.30

[>>Перейти к новости](#)

[>>Перейти ко всем новостям](#)